

特点

- 非常高的功率增益
- 低噪声系数
- 高转换频率
- 发射器是热导
- 低反馈电容。

应用

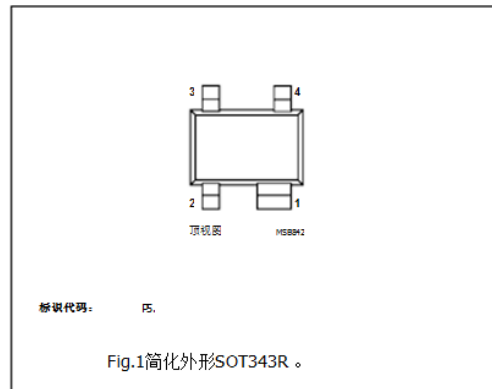
- RF前端
- 宽带应用，例如模拟和数字蜂窝电话机，无绳电话（PHS， DECT等）
- 雷达探测器
- 寻呼机
- 卫星电视调谐器（SATV）
- 高频率的振荡器。

描述

NPN双重多晶硅宽带晶体管管理
层，用于在塑料，4针低压应用
双发射SOT343R包。

钉扎

针	描述
1	辐射源
2	BASE
3	辐射源
4	集热器



快速参考数据

符号	参数	条件	分钟	典型值	马克斯	单位
V_{CE0}	集电极 - 基极电压	发射极开路	-	-	10	V
$V_{CE(sat)}$	集电极 - 发射极电压开基		-	-	4.5	V
I_c	集电极电流 (DC)		-	25	30	mA
$P_{总}$	总功耗	$T_s = 103^{\circ}C$	-	-	135	mW
h_{FE}	直流电流增益	$I_c = 25$ 毫安; $V_{CE} = 2$ V ; $T_s = 25^{\circ}C$	50	80	120	
C_{re}	反馈电容	$I_c = 0$; $V_{CE} = 2$ V ; $F = 1$ MHz的	-	95	-	fF
f_T	跃迁频率	$I_c = 25$ 毫安; $V_{CE} = 2$ V ; $F = 2$ GHz的 $T_s = 25^{\circ}C$	-	25	-	GHz的
$G_{最大}$	最大功率增益	$I_c = 25$ 毫安; $V_{CE} = 2$ V ; $F = 2$ GHz的 $T_s = 25^{\circ}C$	-	20	-	dB
F	噪声系数	$I_c = 2$ 毫安; $V_{CE} = 2$ V ; $F = 2$ GHz的 $T_s = 25^{\circ}C$	-	1.2	-	dB